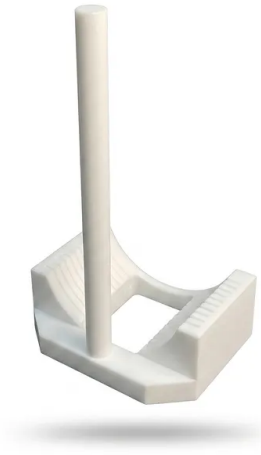


6英寸聚四氟乙烯晶圆清洗架 用于湿法蚀刻 耐酸碱氟聚合物晶圆载具

货号: PL-CP421



简介

专为严苛湿法蚀刻工艺设计的高纯度6英寸聚四氟乙烯晶圆清洗架。这些耐酸氟聚合物载具为半导体制造以及要求苛刻的实验室痕量分析和化学处理应用提供了卓越的化学稳定性和超低污染。

[了解更多](#)

应用领域	描述	主要优势
半导体湿法蚀刻	在氢氟酸、缓冲氧化物蚀刻剂或热磷酸槽中处理硅晶圆。	防止金属污染，并能耐受强腐蚀性化学物质。
太阳能电池制造	为光伏电池生产清洗和纹理化硅基板。	大批量耐用性，耐强碱性纹理化溶液。
痕量金属分析	在ICP-MS分析前清洗实验室玻璃器皿和基板。	超低背景水平和零离子浸出，确保数据精确。
MEMS制造	在深反应离子蚀刻或湿法释放过程中处理微机电系统。	对脆弱结构进行精密尺寸的精细处理。
化学气相沉积	基板预清洗，以确保高质量的薄膜生长。	通过抵抗预处理酸，确保原子级清洁的表面。
制药清洗	制药研发中高纯度组件的灭菌和清洗。	符合FDA标准的材料，对灭菌剂具有优异的耐受性。
电镀工艺	在酸或碱槽中进行精密金属沉积时固定基板。	电绝缘性，并完全耐受电镀电解液。

规格类别	PL-CP421 详情
型号	PL-CP421
基材	高纯度原生聚四氟乙烯（可根据要求提供PFA/TFM）
主要晶圆直径	6英寸（150毫米）标准
晶圆容量	完全可定制（例如，25槽、50槽或定制数量）
槽宽/间距	可根据基板厚度和间距要求定制
手柄设计	固定式、可拆卸式或延长式（根据槽深定制）
耐温范围	-200°C 至 +260°C（-328°F 至 +500°F）
制造方法	5轴精密CNC加工
表面光洁度	Ra < 0.8µm（典型值）或定制抛光
化学兼容性	通用（除熔融碱金属和元素氟外）
合规性	半导体级 / 痕量分析级